

3.5. Запірний тиристор з МОН-керуванням

Найбільш перспективним із тиристорів є тиристор, керований напругою – запірний тиристор з МОН-керуванням (*MCT-MOS – Controlled Thyristor*). Його еквівалентну схему і позначення наведено на рис. 3.10. Він містить МОН-структури з *n*-каналом (*VT4*) та *p*-каналом (*VT1*) і тиристорну чотиришарову структуру *p-n-p-n* (*VT2*, *VT3*). Вмикають його по затвору *n*-канального МОН-транзистора *VT1*. Вимикання здійснюється по затвору *p*-канального МОН-транзистора *VT4*, що на короткий час шунтує катодний перехід тиристорної структури: емітерний перехід транзистора *VT2*. Це забезпечує малу потужність кола керування приладу і його сумісність із цифровими пристроями керування.

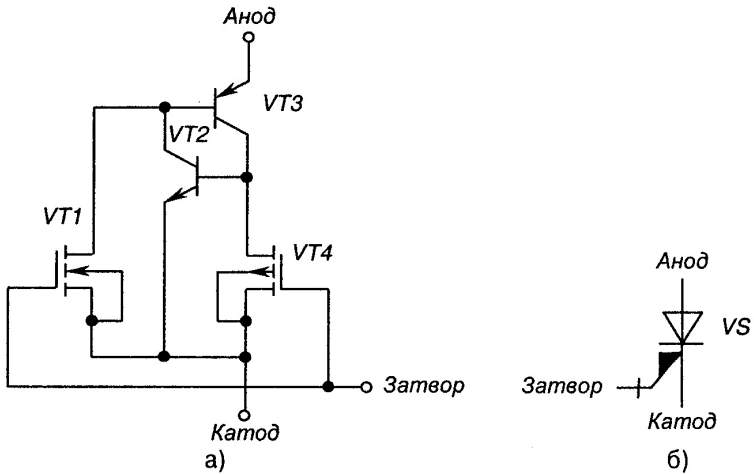


Рис. 3.10 - Еквівалентна схема (а) і позначення (б) запірного тиристора з МОН-керуванням